

## 英飞凌MOSFET功率晶体管

### 英飞凌IPZA65R018CM8 600V CoolMOS™ CM8 功率晶体管

CoolMOS™ 第8代平台是高压功率MOSFET的革命性技术，根据超结(SJ)原理设计，由英飞凌科技率先推出。CM8系列是650V CoolMOS™ 7系列的后继产品，增强了英飞凌的WBG产品。它结合了快速开关SJ MOSFET的优点和出色的易用性，例如低振铃趋势、为所有产品实施快速体二极管(CFD)，具有出色的抗硬换向稳健性和出色的ESD能力。此外，CM8的开关和导通损耗极低，使得开关应用更加高效。

### 特性

- 同类最佳的650V SJ MOSFET性能
- 由于具有出色的换向稳健性，适用于硬开关和软开关拓扑
- 集成快速体二极管和ESD保护功能
- XT互连技术，实现行业领先的热性能

### 优点

- 低振铃趋势使其在PFC和PWM阶段均可实现易于使用和快速设计
- 得益于我们先进的芯片贴装技术，简化了热管理
- 由于采用最先进的ESD保护技术，可以使用封装更小、制造质量更高的产品，实现更高的功率密度解决方案
- 适用于多种应用和功率范围

### 潜在应用

- 电源和转换器
- PFC级和LLC谐振转换器
- 高效开关应用
- 例如数据中心，AI服务器，电信电源

### 产品验证

完全符合JEDEC工业应用标准

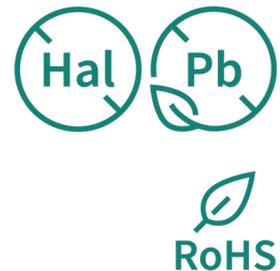
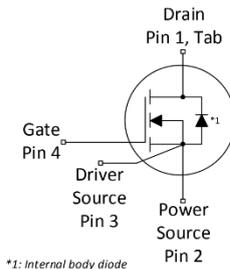
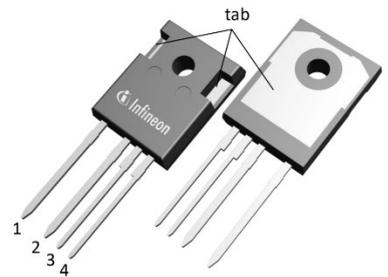
请注意：对于MOSFET并联，通常建议在栅极上使用铁氧体磁珠或单独的图腾柱。

表 1 主要性能参数

Parameter	Value	Unit
$V_{DS} @ T_{j,max}$	700	V
$R_{DS(on),max}$	18	mΩ
$Q_{g,typ}$	173	nC
$I_{D,pulse}$	505	A
$E_{oss} @ 400V$	19.6	μJ
Body diode $di_F/dt$	1300	A/μs
ESD class (HBM)	2	

Part number	Package	Marking	Related links
IPZA65R018CM8	PG-TO247-4	65R018C8	see Appendix A

PG-TO247-4





## 目录

描述 .....	1
最大额定值 .....	3
热特性 .....	4
电气特性 .....	5
电气特性图 .....	7
测试电路 .....	11
封装外形 .....	12
附录 A .....	13
修订记录 .....	14
商标 .....	15
免责声明 .....	15

## 1 最大额定值

除非另有规定， $T_j = 25^\circ\text{C}$

表 2 最大额定值

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Continuous drain current <sup>1)</sup>	$I_D$	-	-	116	A	$T_C=25^\circ\text{C}$
				73		$T_C=100^\circ\text{C}$
Pulsed drain current <sup>2)</sup>	$I_{D,pulse}$	-	-	505	A	$T_C=25^\circ\text{C}$
Avalanche energy, single pulse	$E_{AS}$	-	-	297	mJ	$I_D=6.7\text{A}; V_{DD}=50\text{V};$ see table 10
Avalanche energy, repetitive	$E_{AR}$	-	-	1.48		
Avalanche current, single pulse	$I_{AS}$	-	-	6.7	A	-
MOSFET dv/dt ruggedness	dv/dt	-	-	120	V/ns	$V_{DS}=0\dots400\text{V}$
Gate source voltage (static)	$V_{GS}$	-20	-	20	V	static;
Gate source voltage (dynamic)	$V_{GS}$	-30	-	30	V	AC ( $f>1\text{ Hz}$ )
Power dissipation	$P_{tot}$	-	-	521	W	$T_C=25^\circ\text{C}$
Storage temperature	$T_{stg}$	-55	-	150	$^\circ\text{C}$	-
Operating junction temperature	$T_j$					
Extended operating junction temperature	$T_j$	150	-	175	$^\circ\text{C}$	$\leq 50\text{ h}$ in the application lifetime
Mounting torque	-	-	-	60	Ncm	M3 and M3.5 screws
Continuous diode forward current	$I_S$	-	-	116	A	$T_C=25^\circ\text{C}$
Diode pulse current <sup>2)</sup>	$I_{S,pulse}$			505		
Reverse diode dv/dt <sup>3)</sup>	dv/dt	-	-	70	V/ns	$V_{DS}=0\dots400\text{V}, I_{SD}\leq 116\text{A}, T_j=25^\circ\text{C}$ see table 8
Maximum diode commutation speed	di <sub>F</sub> /dt			1300	A/ $\mu\text{s}$	
Insulation withstand voltage	$V_{ISO}$	-	-	n.a.	V	$V_{rms}, T_C=25^\circ\text{C}, t=1\text{min}$

1) 受  $T_{j,max}$  限制

2) 脉冲宽度  $t_p$  受  $T_{j,max}$  限制

3) 相同的低侧和高侧开关，具有相同的  $R_G$

## 2 热特性

表 3 热特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Thermal resistance, junction - case	$R_{thJC}$	-	-	0.24	K/W	-
Thermal resistance, junction - ambient	$R_{thJA}$	-	-	62	K/W	leaded
Thermal resistance, junction - ambient for SMD version	$R_{thJA}$	-	-	-	K/W	-
Soldering temperature, wavesoldering only allowed at leads	$T_{sold}$	-	-	260	°C	1.6mm (0.063 in.) from case for 10s

### 3 电气特性

除非另有规定,  $T_j = 25^\circ\text{C}$

表 4 静态特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	650	-	-	V	$V_{GS}=0V, I_D=1mA$
Gate threshold voltage	$V_{(GS)th}$	3.7	4.2	4.7	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=1.48mA$
Zero gate voltage drain current	$I_{DSS}$	-	-	2	$\mu A$	$V_{DS}=650V, V_{GS}=0V, T_j=25^\circ C$
			244	-		$V_{DS}=650V, V_{GS}=0V, T_j=150^\circ C$
Gate-source leakage current	$I_{GSS}$	-	-	0.1	$\mu A$	$V_{GS}=20V, V_{DS}=0V$
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	-	0.015	0.018	$\Omega$	$V_{GS}=10V, I_D=55.6A, T_j=25^\circ C$
			0.033	-		$V_{GS}=10V, I_D=55.6A, T_j=150^\circ C$
Gate resistance	$R_G$	-	1	-	$\Omega$	$f=1MHz$

表 5 动态特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Input capacitance	$C_{iss}$	-	8290	-	pF	$V_{GS}=0V, V_{DS}=400V, f=250kHz$
Output capacitance	$C_{oss}$	-	91	-		
Effective output capacitance, energy related <sup>4)</sup>	$C_{o(er)}$	-	245	-	pF	$V_{GS}=0V, V_{DS}=0...400V$
Effective output capacitance, time related <sup>5)</sup>	$C_{o(tr)}$	-	2702	-	pF	$I_D=constant, V_{GS}=0V, V_{DS}=0...400V$
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	-	33.5	-	ns	$V_{DD}=400V, V_{GS}=13V, I_D=29.7A, R_G=1.8\Omega; \text{ see table 9}$
Rise time	$t_r$		10.5			
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		145			
Fall time	$t_f$		5.1			

4)  $C_{o(er)}$  是一个固定电容, 当  $V_{DS}$  从 0 上升至 400 V 时, 其存储能量与  $C_{oss}$  相同

5)  $C_{o(tr)}$  是一个固定电容, 当  $V_{DS}$  从 0 上升至 400 V 时, 其充电时间与  $C_{oss}$  相同

表 6 栅极电荷特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Gate to source charge	$Q_{gs}$	-	48	-	nC	$V_{DD}=400V, I_D=29.7A, V_{GS}=0 \text{ to } 10V$
Gate to drain charge	$Q_{gd}$	-	54	-	nC	
Gate charge total	$Q_g$	-	173	-	nC	
Gate plateau voltage	$V_{plateau}$	-	5.8	-	V	

表 7 反向二极管特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Diode forward voltage	$V_{SD}$	-	0.9	-	V	$V_{GS}=0V, I_F=29.7A, T_j=25^\circ C$
Reverse recovery time	$t_{rr}$	-	180	225	ns	$V_R=400V, I_F=29.7A, di_F/dt=100A/\mu s$ ; see table 8
Reverse recovery charge	$Q_{rr}$	-	1.54	2.31	$\mu C$	
Peak reverse recovery current	$I_{rrm}$	-	16.4	-	A	

## 4 电气特性图

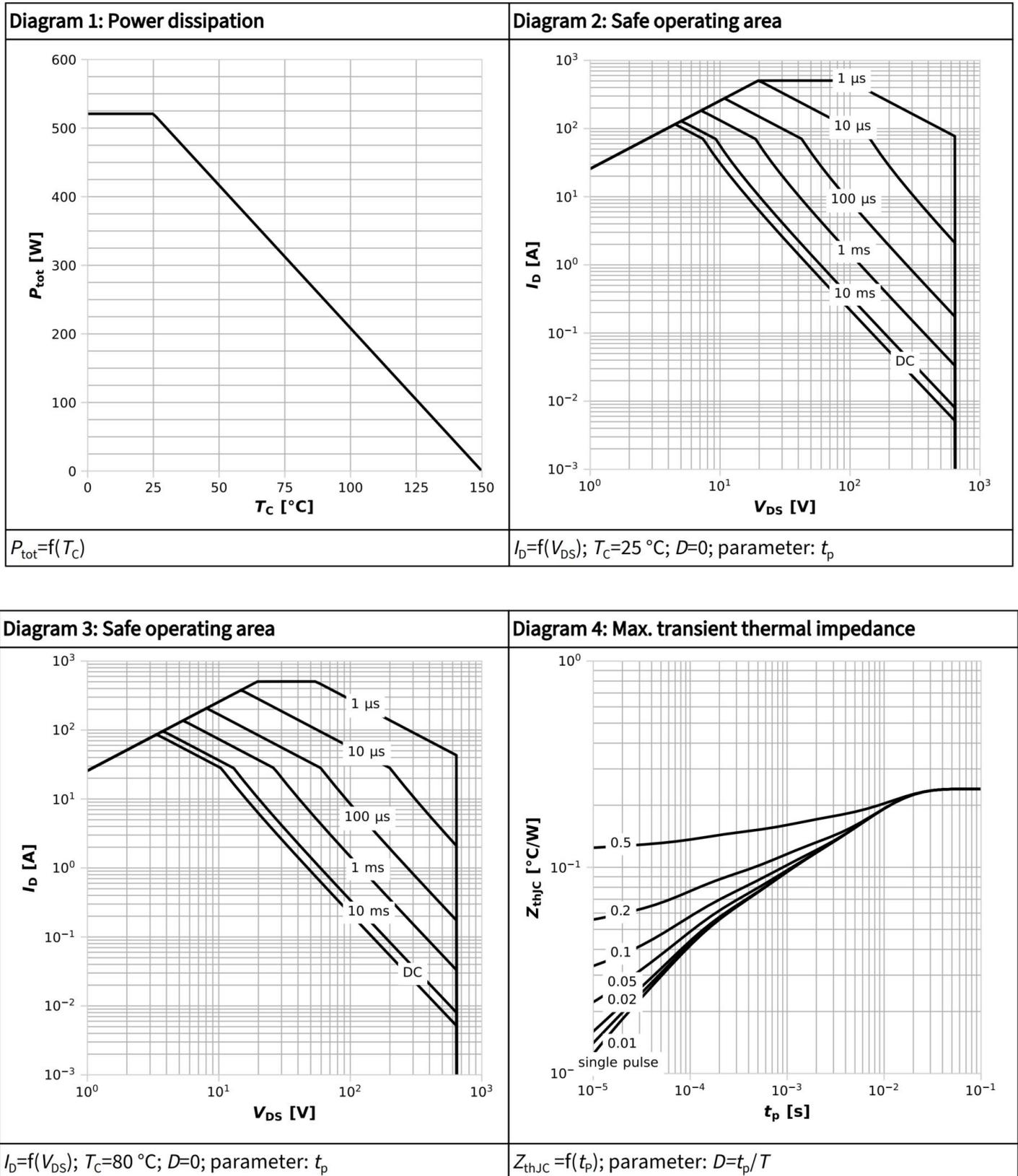


Diagram 5: Typ. output characteristics

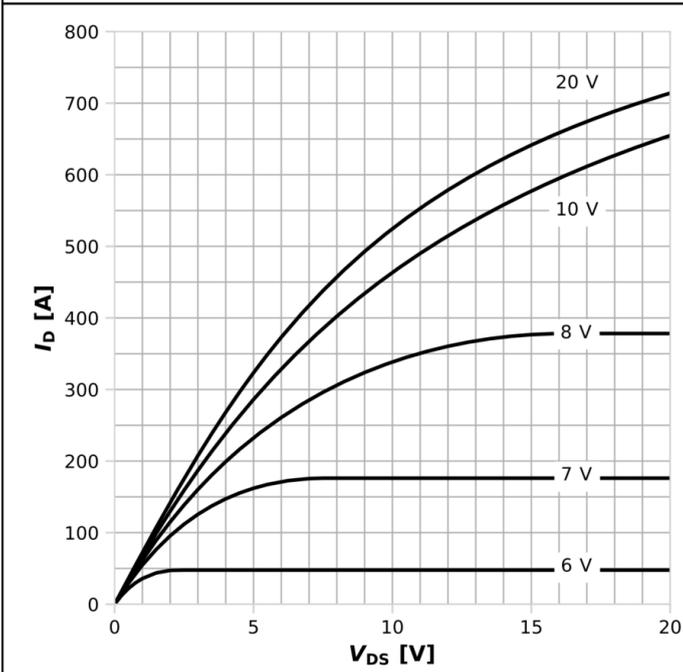

 $I_D = f(V_{DS}); T_j = 25\text{ °C}; \text{parameter: } V_{GS}$ 

Diagram 6: Typ. output characteristics

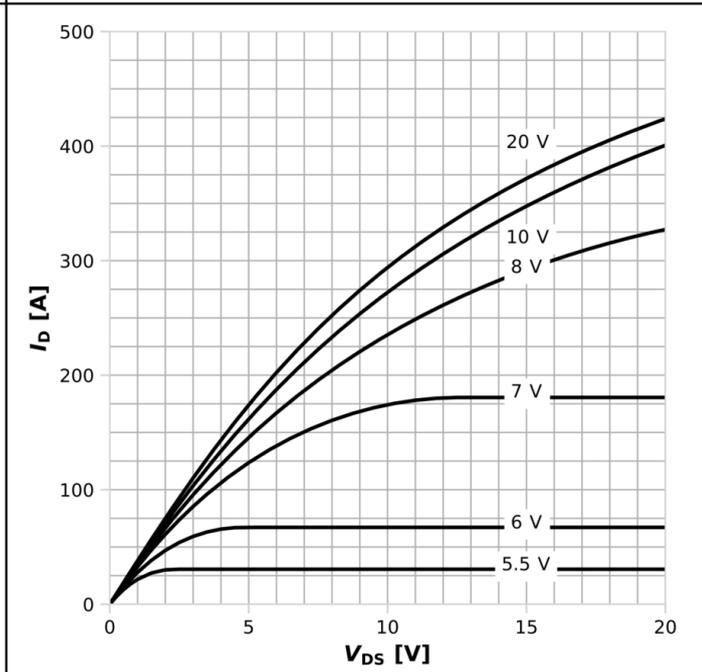

 $I_D = f(V_{DS}); T_j = 125\text{ °C}; \text{parameter: } V_{GS}$ 

Diagram 7: Typ. drain-source on-state resistance

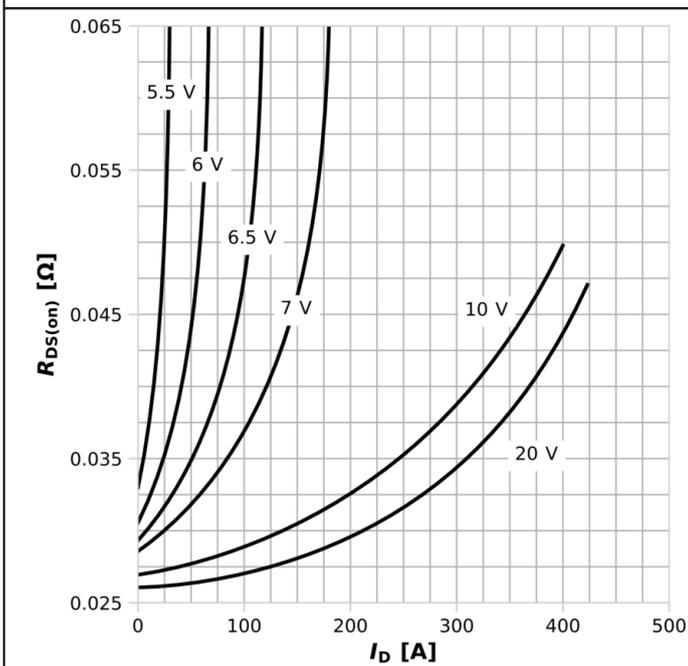

 $R_{DS(on)} = f(I_D); T_j = 125\text{ °C}; \text{parameter: } V_{GS}$ 

Diagram 8: Drain-source on-state resistance

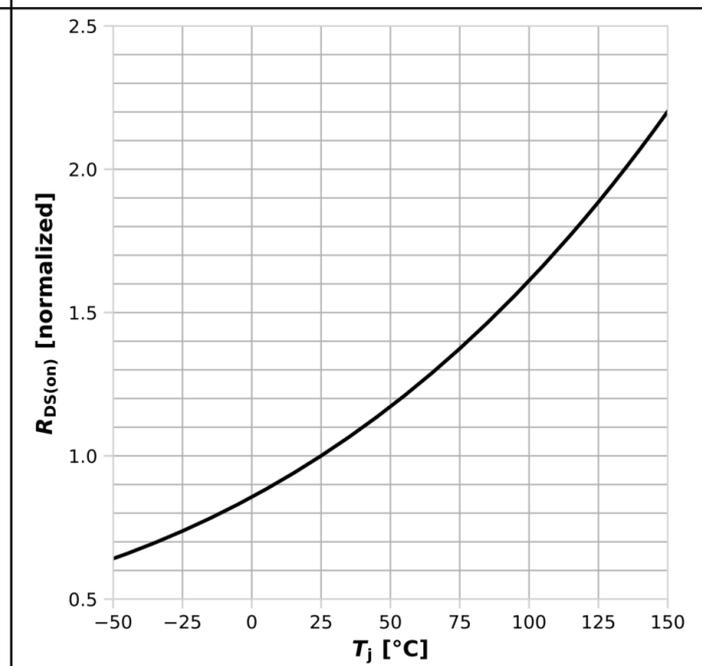

 $R_{DS(on)} = f(T_j); I_D = 55.6\text{ A}; V_{GS} = 10\text{ V}$

Diagram 9: Typ. transfer characteristics

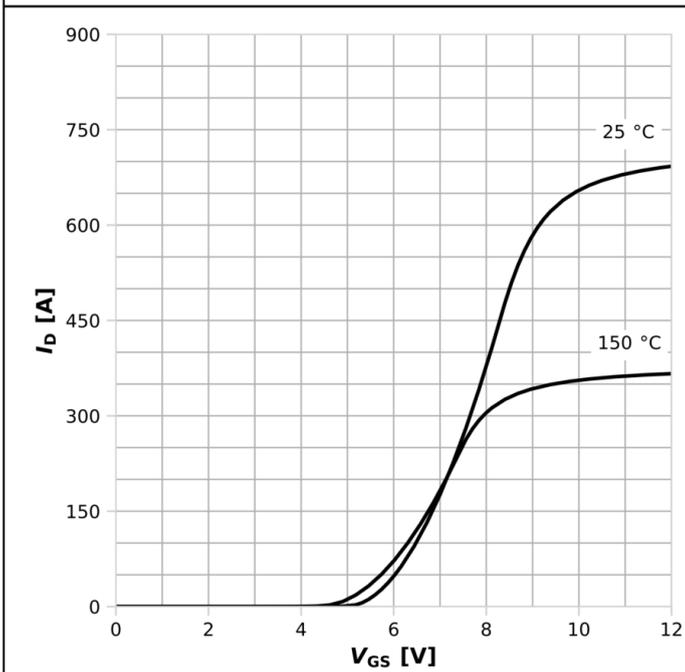

 $I_D = f(V_{GS}); V_{DS} = 20V; \text{parameter: } T_j$ 

Diagram 10: Typ. gate charge

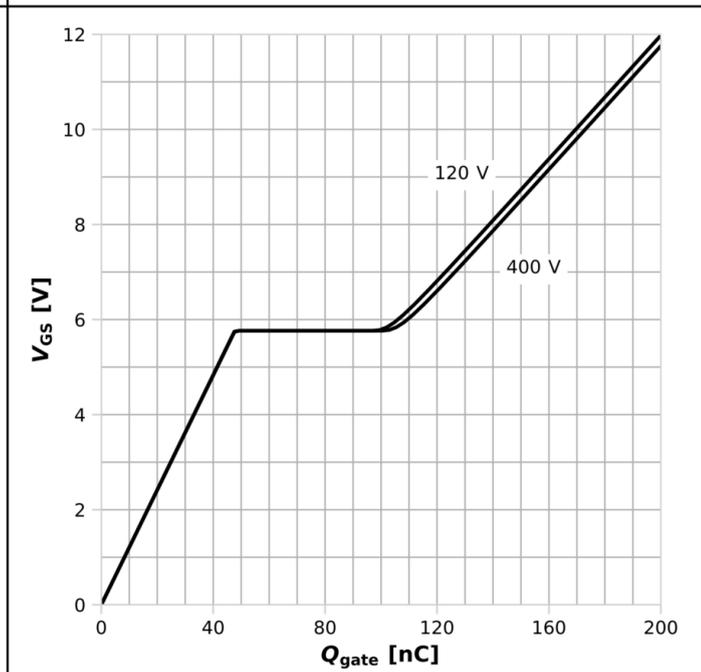

 $V_{GS} = f(Q_{gate}); I_D = 29.7 \text{ A pulsed}; \text{parameter: } V_{DD}$ 

Diagram 11: Forward characteristics of reverse diode

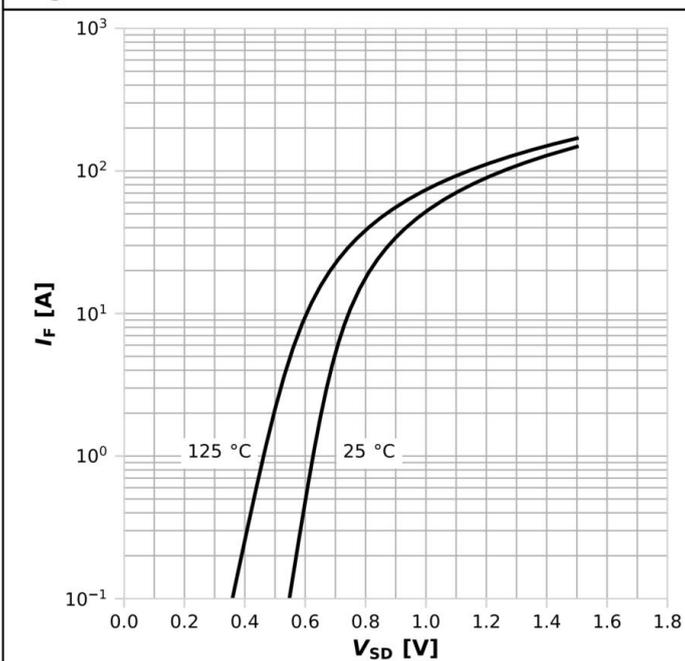

 $I_F = f(V_{SD}); \text{parameter: } T_j$ 

Diagram 12: Avalanche energy

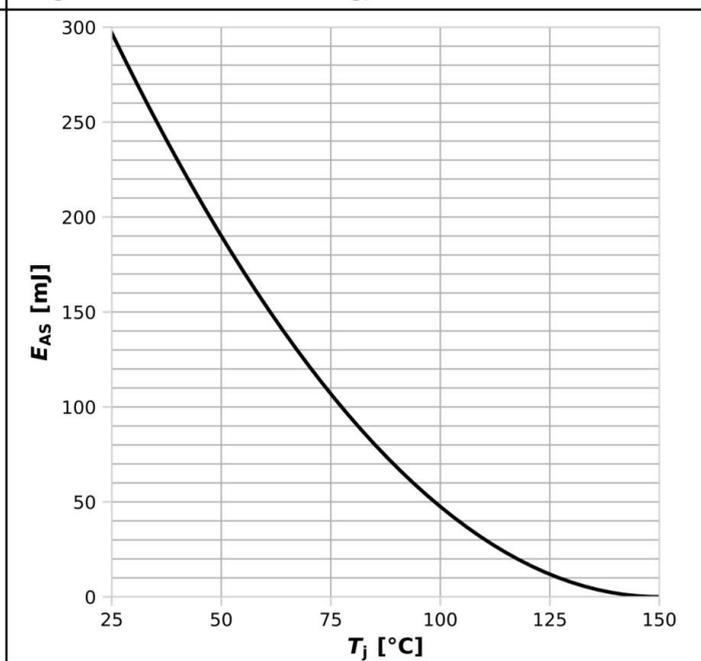
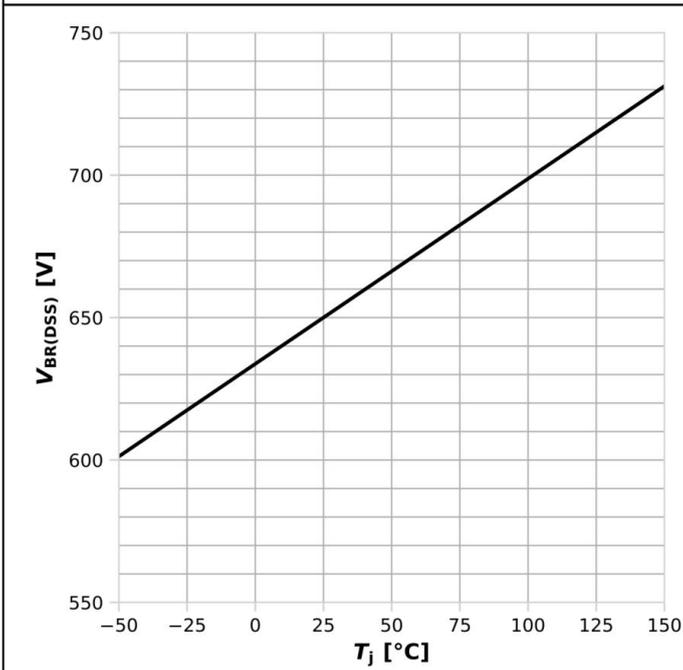
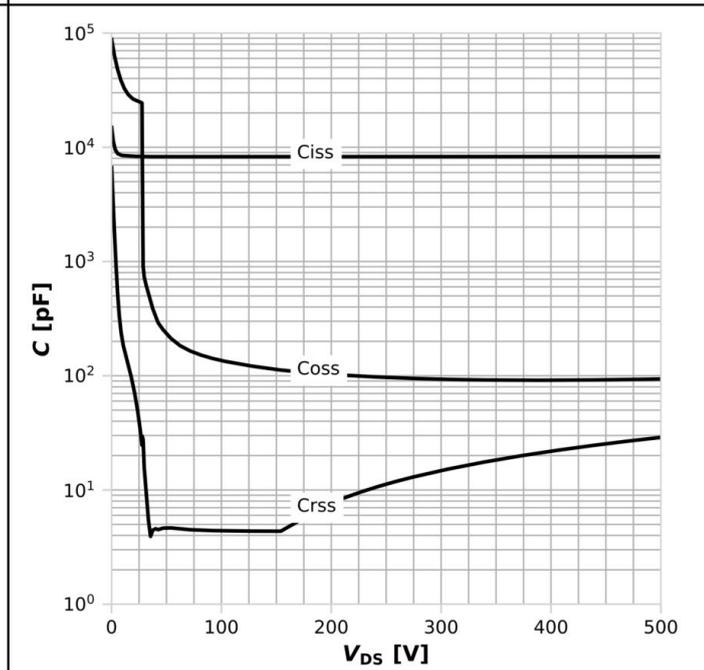

 $E_{AS} = f(T_j); I_D = 6.7 \text{ A}; V_{DD} = 50 \text{ V}$

Diagram 13: Drain-source breakdown voltage



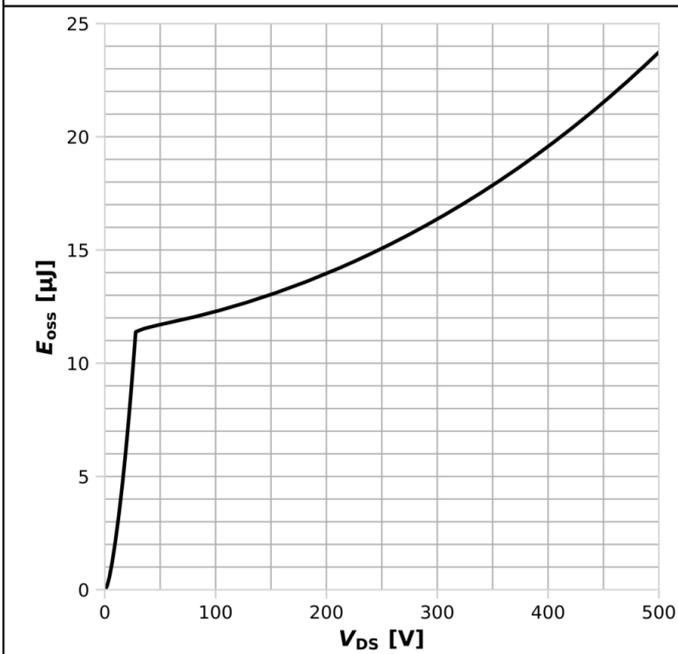
$$V_{BR(DSS)} = f(T_j); I_D = 10 \text{ mA}$$

Diagram 14: Typ. capacitances



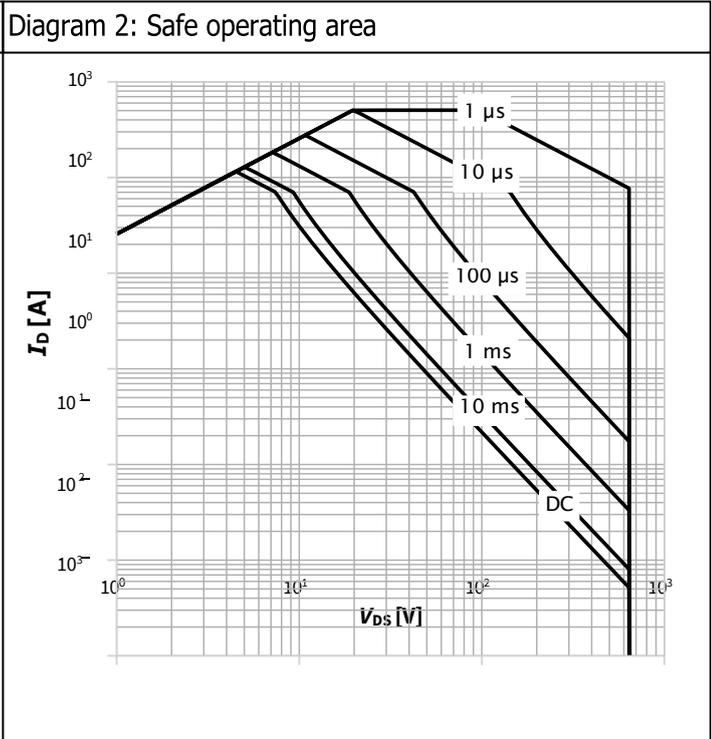
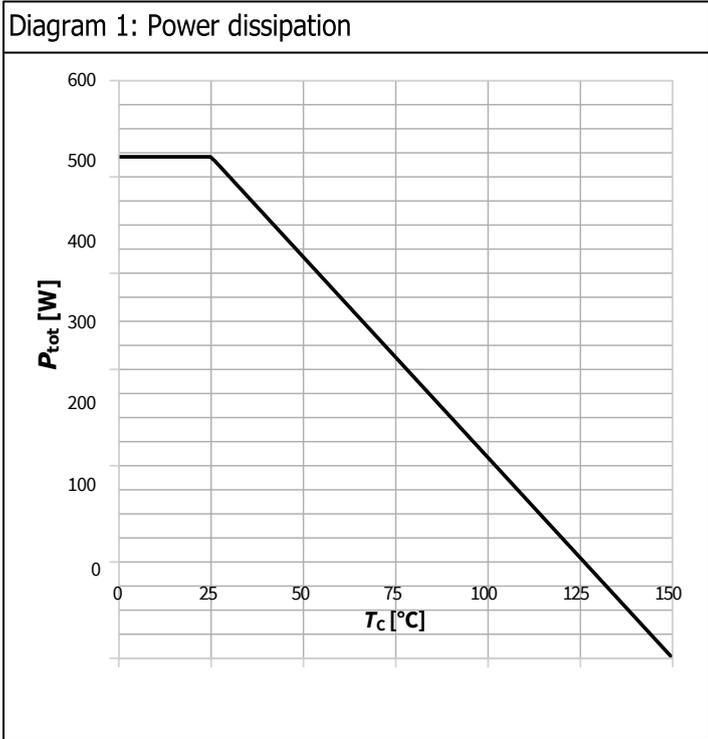
$$C = f(V_{DS}); V_{GS} = 0 \text{ V}; f = 250 \text{ kHz}$$

Diagram 15: Typ. Coss stored energy



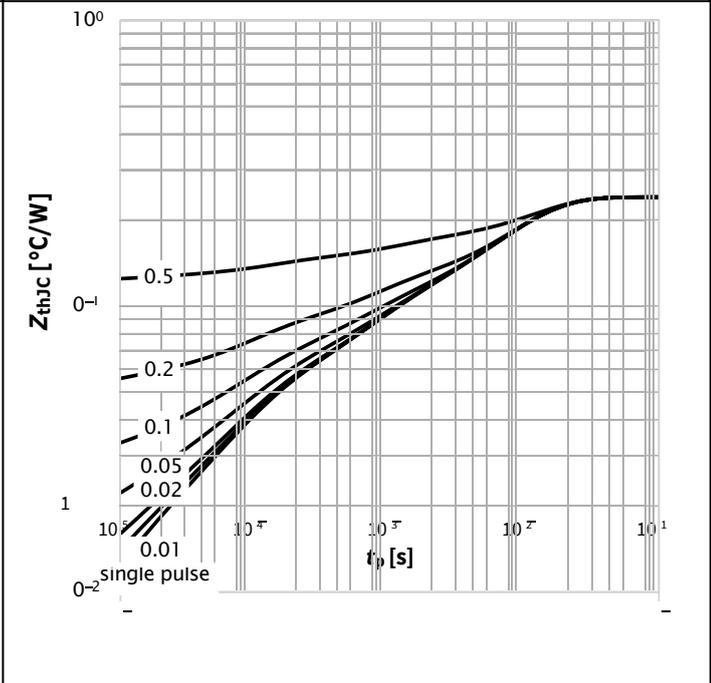
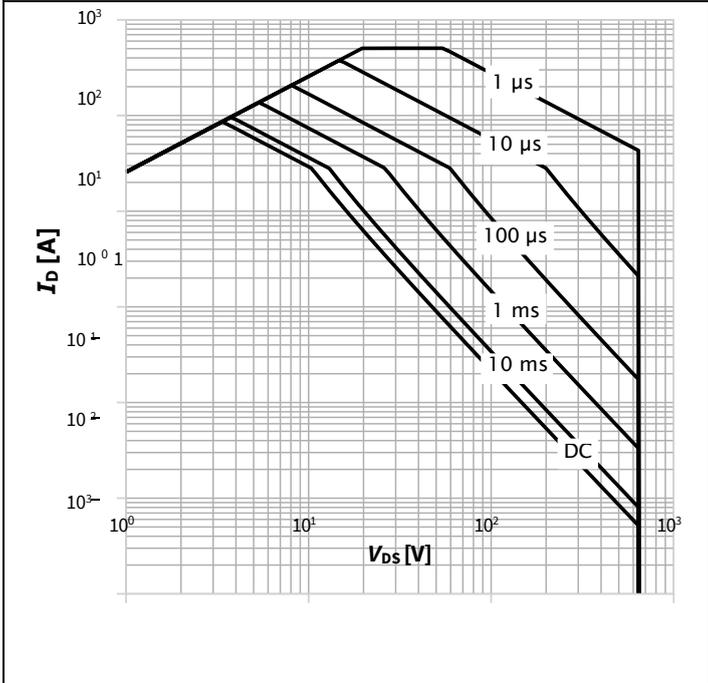
$$E_{oss} = f(V_{DS})$$

Xxxx



$P_{tot} = f(T_c)$   
Diagram 3: Safe operating area

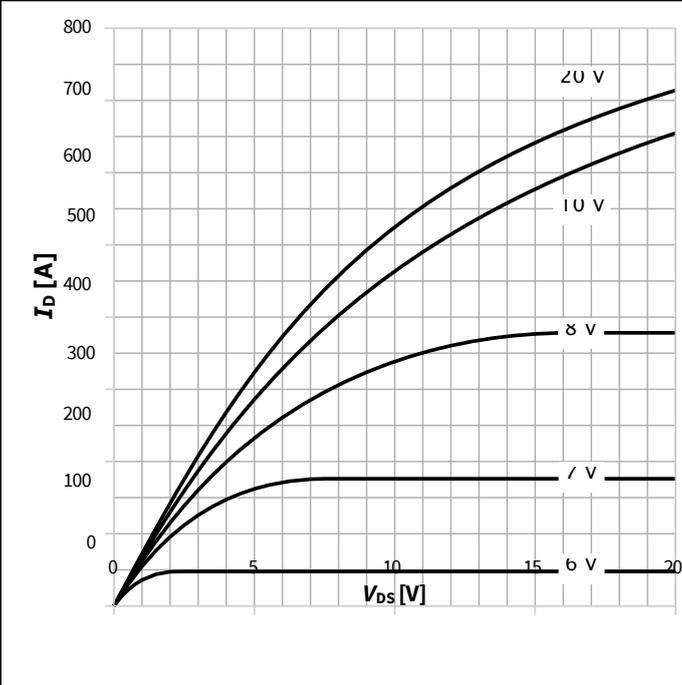
$I_D = f(V_{DS}); T_c = 25\text{ °C}; D = 0$ ; parameter:  $t_p$   
图 4: 最大 transient thermal impedance



$I_D = f(V_{DS}); T_c = 80\text{ °C}; D = 0$ ; parameter:  $t_p$

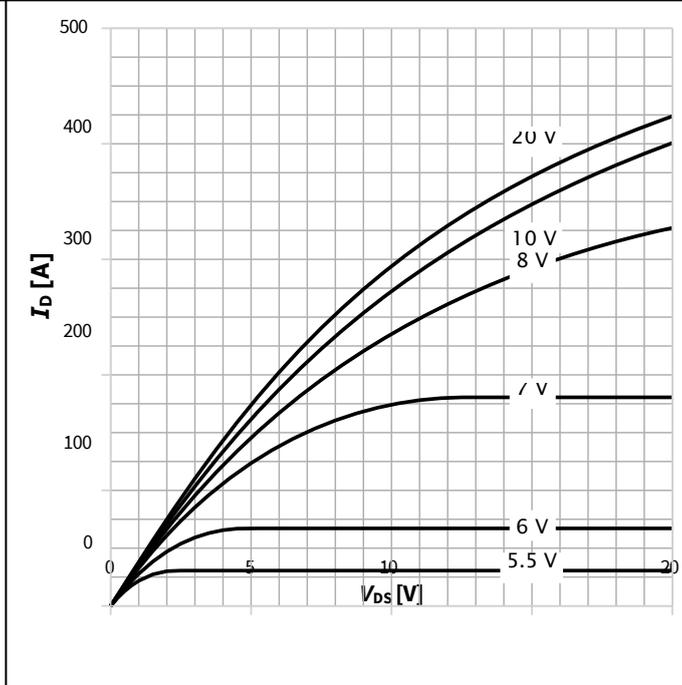
$Z_{thJC} = f(t_p)$ ; parameter:  $D = t_p / T$

图 5: 典型output characteristics



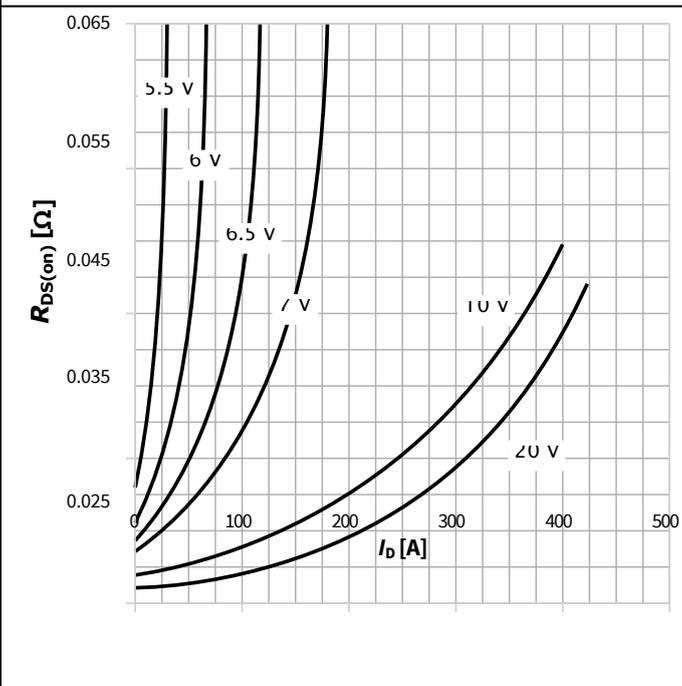
$I_D = f(V_{DS})$ ;  $T_j = 25\text{ °C}$ ; parameter:  $V_{GS}$

图 6: 典型output characteristics



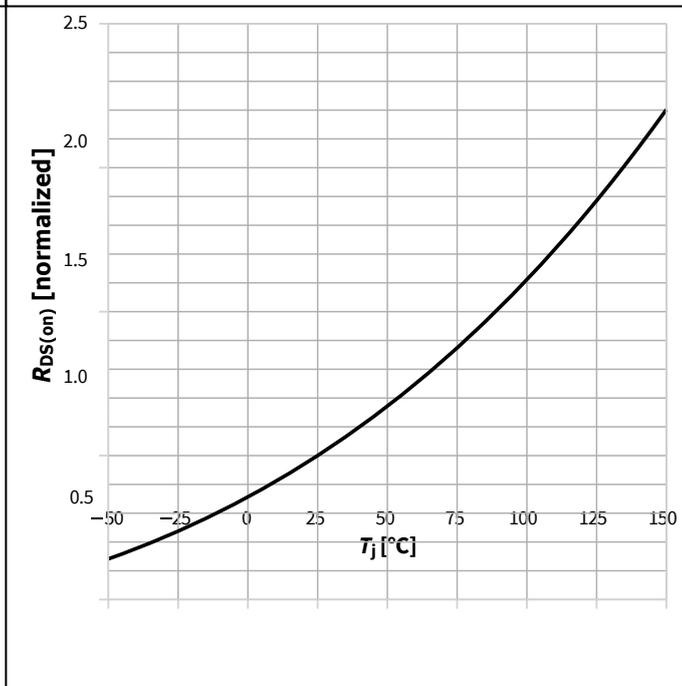
$I_D = f(V_{DS})$ ;  $T_j = 125\text{ °C}$ ; parameter:  $V_{GS}$

图 7: 典型drain-source on-state resistance



$R_{DS(on)} = f(I_D)$ ;  $T_j = 125\text{ °C}$ ; parameter:  $V_{GS}$

Diagram 8: Drain-source on-state resistance



$R_{DS(on)} = f(T_j)$ ;  $I_D = 55.6\text{ A}$ ;  $V_{GS} = 10\text{ V}$

Diagram 9: Typ. transfer characteristics

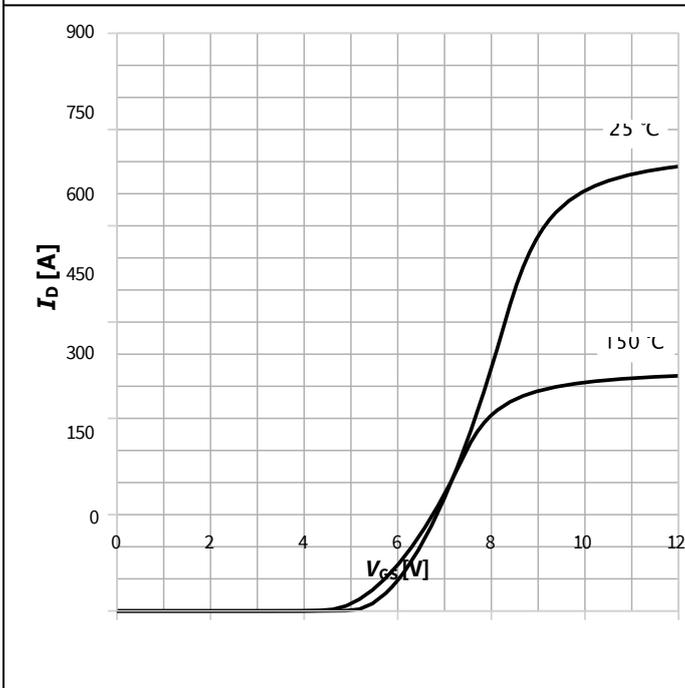

 $I_D = f(V_{GS}); V_{DS} = 20V; \text{parameter: } T_j$ 

Diagram 11: Forward characteristics of reverse diode

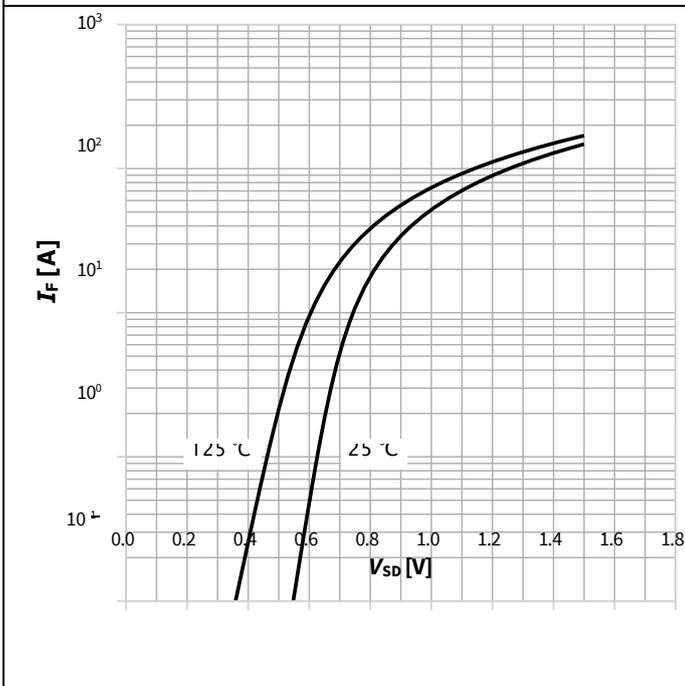

 $I_F = f(V_{SD}); \text{parameter: } T_j$ 

Diagram 10: Typ. gate charge

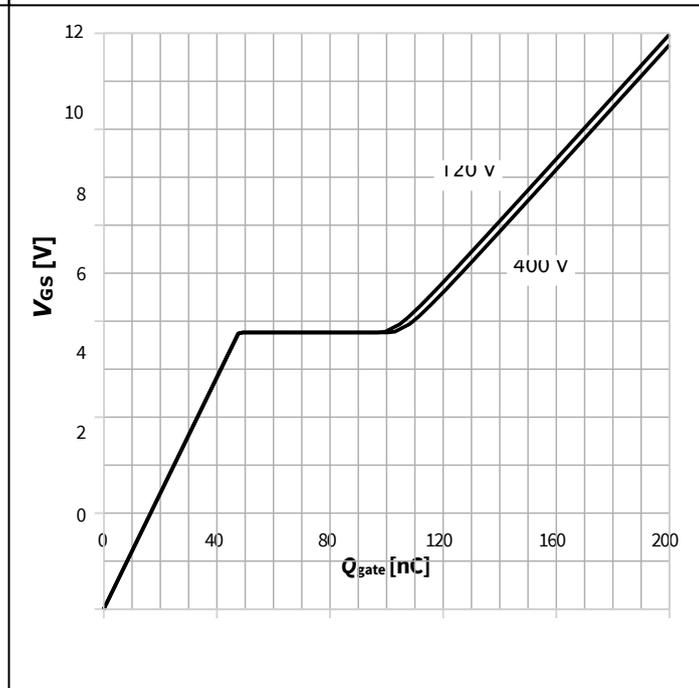

 $V_{GS} = f(Q_{gate}); I_D = 29.7 \text{ A pulsed}; \text{parameter: } V_{DD}$ 

Diagram 12: Avalanche energy

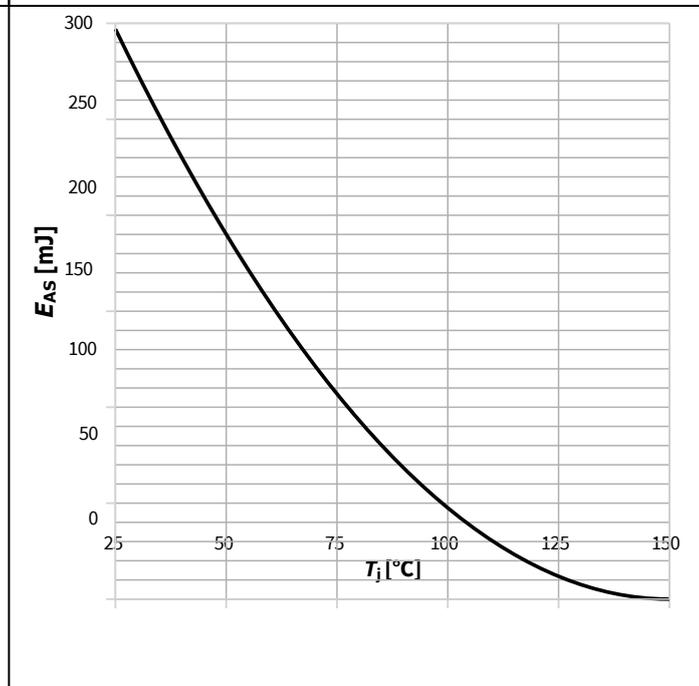
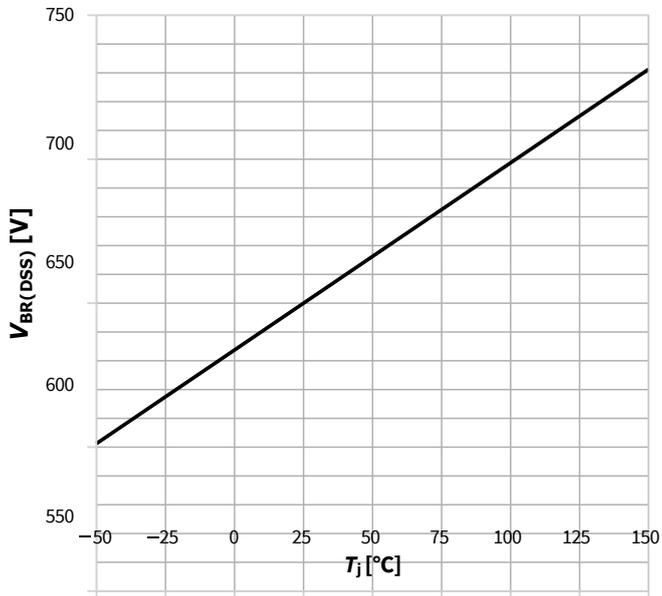
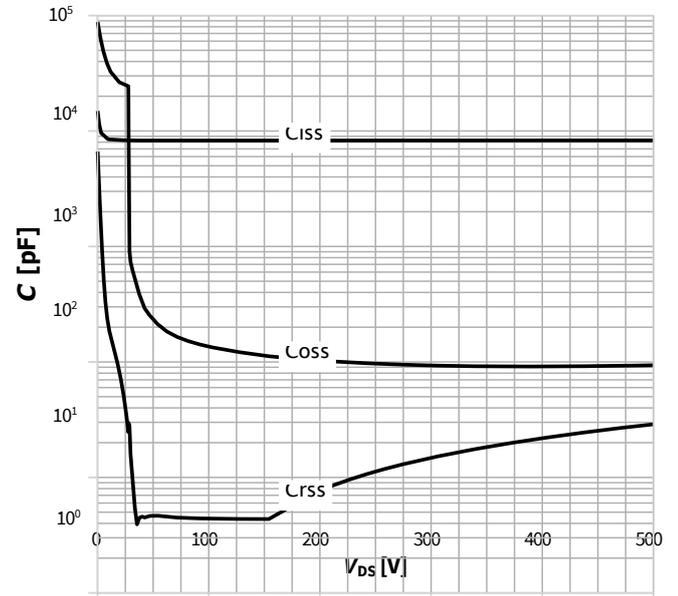

 $E_{AS} = f(T_j); I_D = 6.7 \text{ A}; V_{DD} = 50 \text{ V}$

Diagram 13: Drain-source breakdown voltage



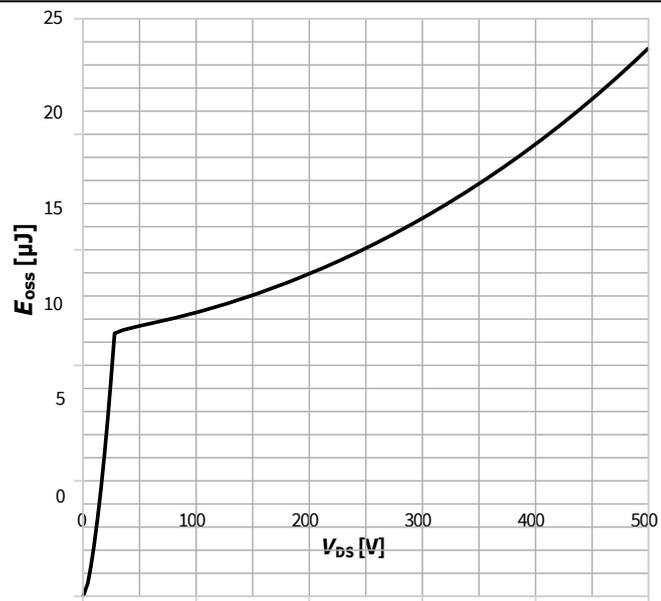
$$V_{BR(DSS)} = f(T_j); I_D = 10 \text{ mA}$$

Diagram 14: Typ. capacitances



$$C = f(V_{DS}); V_{GS} = 0 \text{ V}; f = 250 \text{ kHz}$$

Diagram 15: Typ. Coss stored energy



$$E_{oss} = f(V_{DS})$$

## 5 测试电路

表 8 二极管特性

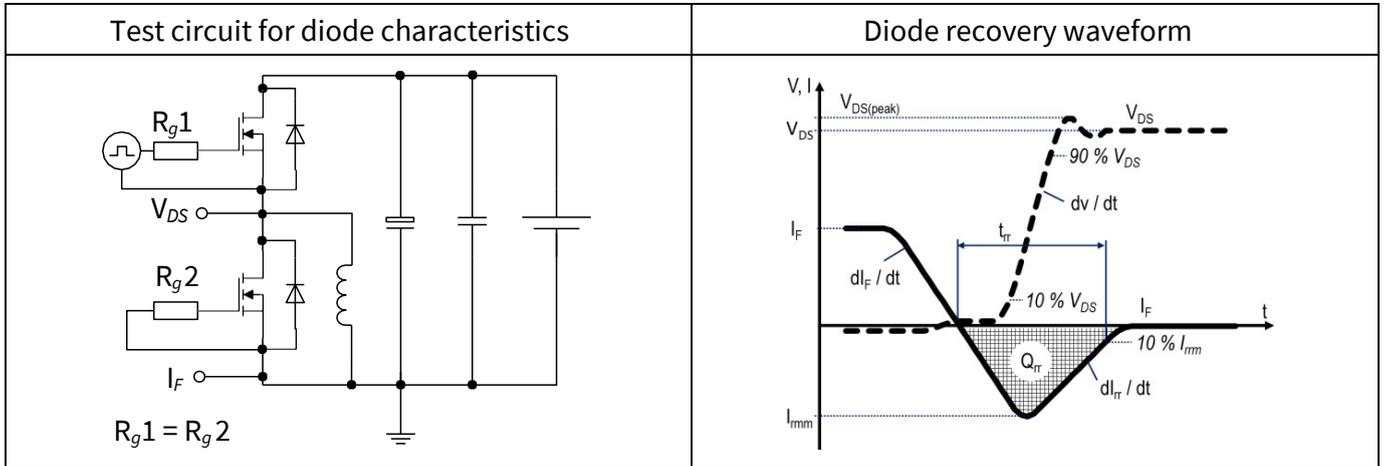


表 9 切换时间 (ss)

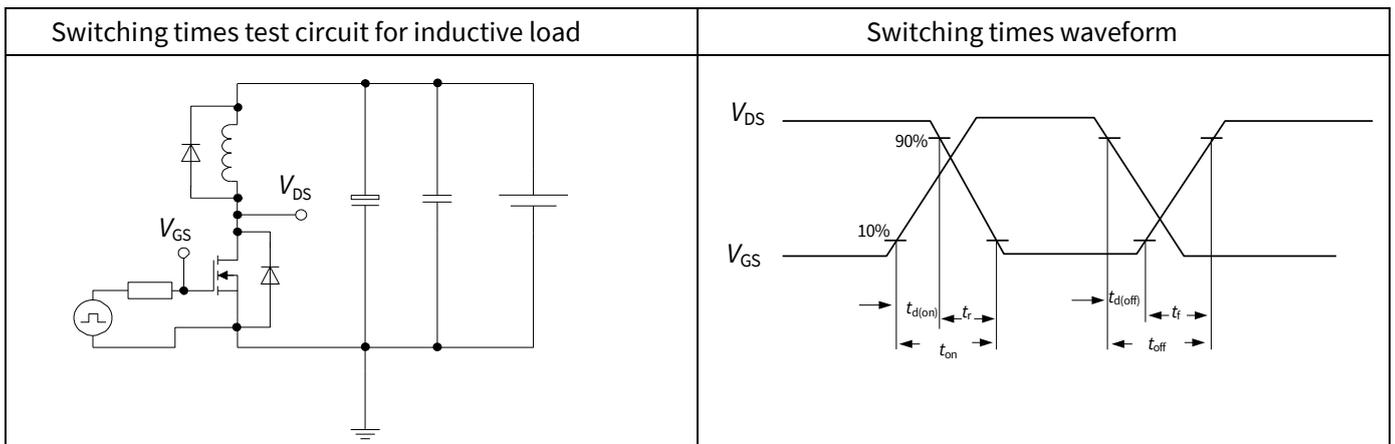
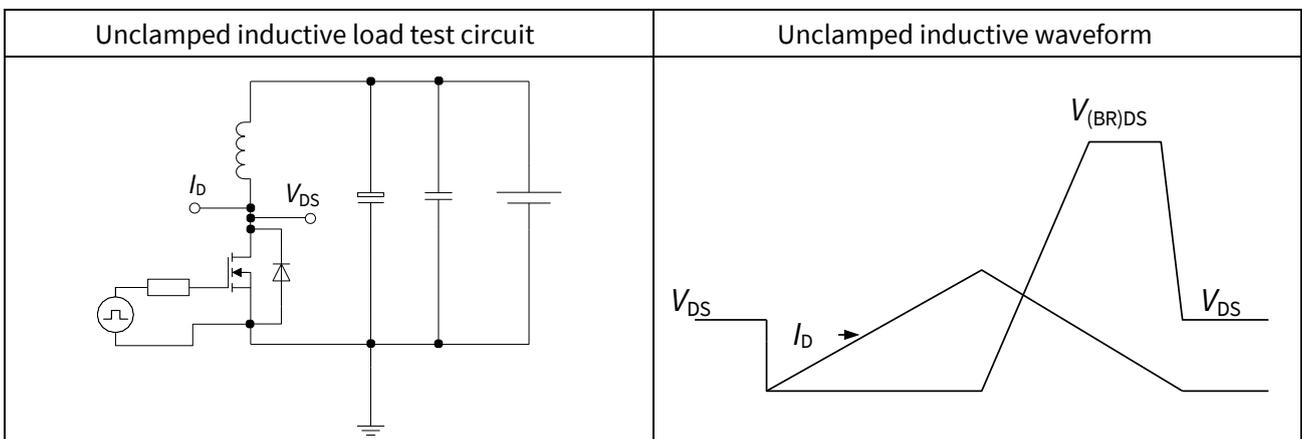
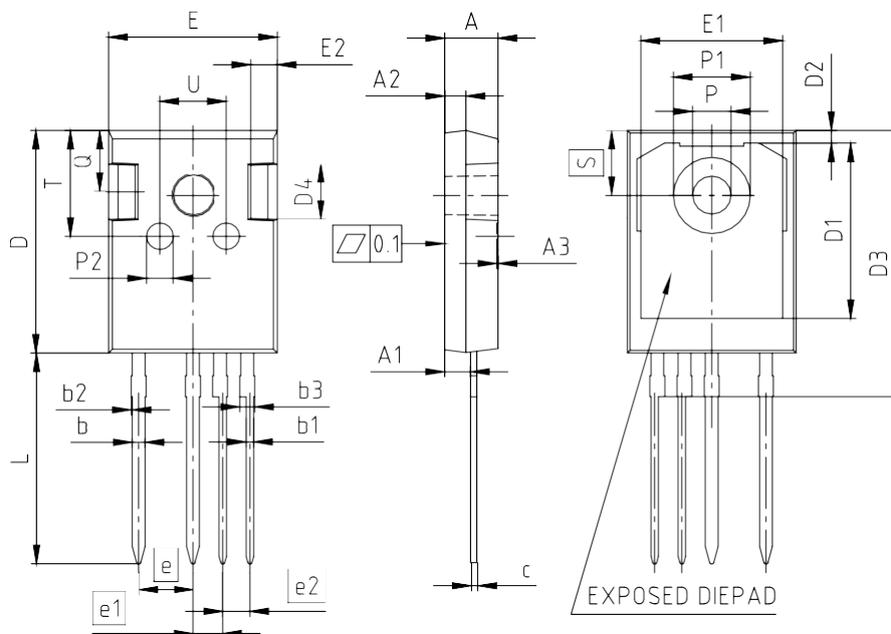


表 10 非钳位感性负载 (ss)



## 6 封装外形



### NOTES:

DIMENSIONS DO NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSION OR GATE BURRS

PACKAGE - GROUP NUMBER: PG-TO247-4-U02					
DIMENSIONS	MILLIMETERS		DIMENSIONS	MILLIMETERS	
	MIN.	MAX.		MIN.	MAX.
A	4.90	5.10	E	15.70	15.90
A1	2.31	2.51	E1	13.10	13.50
A2	1.90	2.10	E2	2.40	2.60
A3	0.05	0.25	e	5.08	
b	1.10	1.30	e1	2.79	
b1	0.65	0.79	e2	2.54	
b2	---	0.20	N	4	
b3	1.34	1.44	L	19.80	20.10
c	0.58	0.66	øP	3.50	3.70
D	20.90	21.10	øP1	7.00	7.40
D1	16.25	16.85	øP2	2.40	2.60
D2	1.05	1.35	Q	5.60	6.00
D3	24.97	25.27	S	6.15	
D4	4.90	5.10	T	9.80	10.20
			U	6.00	6.40

图 1 PG-TO247-4 外形图，尺寸单位为毫米

## 7 附录 A

表 11 相关链接

- [IFX CoolMOS CM8 网页](#)
- [IFX CoolMOS CM8 应用说明](#)
- [IFX CoolMOS CM8 仿真模型](#)
- [IFX 设计工具](#)

## 修订记录

IPZA65R018CM8

**Revision: 2025-03-07, Rev. 2.1**

### 历史修订版本

Revision	Date	Subjects (major changes since last revision)
2.0	2024-12-19	Release of final version
2.1	2025-03-07	Update of maximum transient thermal impedance and SOA



## 免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

**您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。**

## Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

## 重要通知

版本 2026-01-26

Infineon Technologies AG 出版，  
德国 Neubiberg 85579

版权 © 2025 Infineon Technologies AG  
及其关联公司。  
保留所有权利。

Do you have a question about this  
document?

Email:

[erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)

Infineon Technologies AG 及其关联公司（以下简称“英飞凌”）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称“产品”），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担不侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文件中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据探勘（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：

由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称“安全漏洞”），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文件包含或引用软件：

根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码 (binary code) 形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 <https://www.infineon.com>。